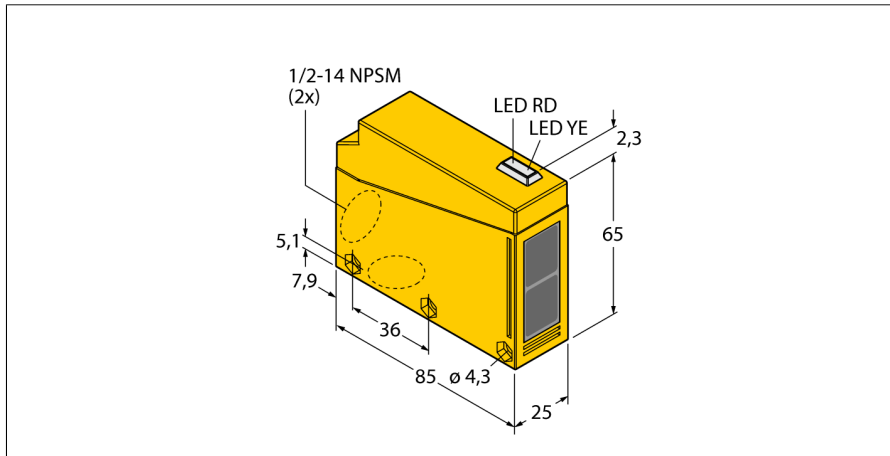
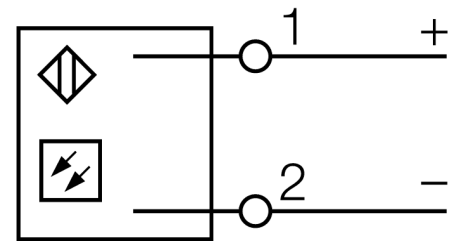


Фотоэлектрический датчик оппозитный датчик (излучатель) Q853E-B

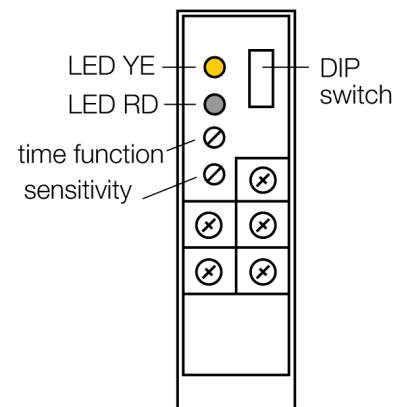


- Встроенная клеммная коробка
- Кабельные сальники, смещенная установка на 90° в двух местах
- Степень защиты IP67
- Рабочее напряжение: 12...240 В DC, 24...240 В AC

Схема подключения



Тип	Q853E-B
Идент. №	3031649
Тип источника света	красн.
Длина волны	680 нм
Диапазон	0...23000 мм
Температура окружающей среды	-25...+55 °C
Рабочее напряжение	12...240 В =
Рабочее напряжение	24...240В AC
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 3000 мА
Номинальный рабочий ток (AC)	≤ 3000 мА
Конструкция	Прямоугольный, Q85
Размеры	85 мм x 65 мм x 25 мм
Диаметр корпуса	0 мм
Материал корпуса	Пластмасса, ABS, Желтый
Линза	акрил, Пластмасса
Электрическое подключение	Клеммная коробка
Поперечное сечение кабеля	2 мм ²
Степень защиты	IP67
Индикация коэффициента усиления	светодиод



Принцип действия

Оппозитные датчики состоят из автономных излучателя и приемника. Они установлены один напротив другого так, что свет от излучателя попадает непосредственно на приемник. Если объект прерывает или ослабляет световой поток, это вызывает переключение устройства. Оппозитные датчики являются наиболее надежными фотоэлектрическими датчиками для детектирования непрозрачных мишеней. Прекрасный контраст между условиями "темно" и "светло" и очень высокий коэффициент усиления типичен для этого способа детектирования, это позволяет работать при больших расстояниях и в сложных условиях, наприм. при загрязнении линз или смещении элементов датчика.

**Фотоэлектрический датчик
оппозитный датчик (излучатель)
Q853E-B**

